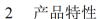


1 产品概述

IRS2104S是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。IRS2104S采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成,逻辑输入电平兼容低至3.3V的CMOS或LSTTL逻辑输出电平。

IRS2104S其浮动通道可用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET,浮地通道最高工作电压可达 700V。 IRS2104S采用 SOP-8 封装,可以在-40℃至 125℃温度范围内工作。



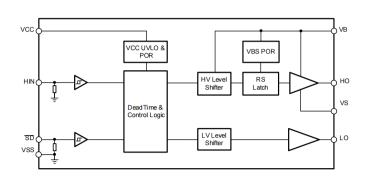
- 自举工作的浮地通道
- 最高工作电压为+700 V
- 兼容 3.3V, 5V 和 15V 输入逻辑
- dVs/dt 耐受能力可达±50 V/ns
- Vs 负偏压能力达-9V
- 集成 VCC 欠压锁定电路
 - -- 欠压锁定正向阈值 8.9V
 - -- 欠压锁定负向阈值 8.2V
- 芯片传输延时特性
 - -- 开通/关断传输延时 Ton/Toff =650ns/130ns
 - -- 延迟匹配时间 50ns
- 防止直通保护
 - -- 死区时间 520ns
- 宽温度范围-40°C~125°C
- 输出级拉电流/灌电流能力 300mA/600mA
- 符合 RoSH 标准 SOIC8 (S)



3 应用范围

- 电机控制
- 空调/洗衣机
- 通用逆变器
- 逆变器驱动

简化示意图





4 引脚功能描述



表 4-1 芯片引脚描述

编号	名称	功能
1	VCC	供电电源
2	IN	高侧和低侧信号输入
3	SD	关断信号输入
4	VSS	地
5	LO	低侧输出
6	VS	高侧浮动地
7	но	高侧输出
8	VB	高侧浮动电源



5 产品规格

5.1 极限工作范围

超过极限最大额定值可能造成器件永久性损坏。所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的,环境温度为 25℃。

符号	定义	最小值	最大值	单位
V_B	高侧浮动电源电压	-0.3	725	
Vs	高侧浮动地电压	V _B – 25	V _B + 0.3	
V_{HO}	高侧输出电压	V _S -0.3	V _B + 0.3	V
V _{CC}	低侧供电电压	-0.3	25	
V_{LO}	低侧输出电压	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	
V_{IN}	逻辑输入电压	-0.3	$V_{CC} + 0.3$	
dVs/dt	允许瞬态 VS 电压转换速率		50	V/ns

5.2 ESD 额定值

符号	定义	最小值	最大值	单位
ESD	人体放电模式	1500		V
	机器放电模式	500	1	V

5.3 额定功率

符号	定义	最小值	最大值	单位
PD1	SOIC 封装功率(TA ≤25°C)	_	625	mVV

5.4 热量信息

符号	定义	最小值	最大值	单位
Rth _{JA}	热阻	-	200	°C/W
T_J	结温	1	150	C/VV
Ts	存储温度	-55	150	°C
TL	引脚温度		300	°C/W

5.5 推荐工作范围

为了正确地操作,器件应当在以下推荐条件下使用。 V_S 和 VSS 的偏置额定值是在电源电压为 15V 时进行测量的,无特殊说明的情况下,所有电压参数的额定值是以 VSS 为参考的,环境温度为 25° C。

符号	定义	最小	最大	单位
V _B	高侧浮动电源电压	V _S + 10	V _S + 20	V
Vs	高侧浮动地电压	-9	700	
V _{HO}	高侧输出电压	Vs	V _B	
V _{CC}	低侧供电电压	10	20	
V _{LO}	低侧输出电压	0	V _{CC}	
V _{IN}	逻辑输入电压	0	V _{CC}	
T _A	环境温度	-40	125	°C

注 1: 可用于 VSS-50V 的瞬态负 VS, 脉冲宽度为 50ns, 由设计保证。

注 2: 当输入脉冲宽度低于 1us 时,输入脉冲不能正常传输



5.6 电气特性

5.6.1 动态参数特性

无特殊说明的情况下 $T_A=25$ °C, $V_{CC}=V_{BS}=15$ V, CL=1nF。

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
ton	开通传输延时	_	650	820	ns	V _S =0V
t _{OFF}	关断传输延时	_	130	200	ns	V _S =700V
t _{sd}	Shutdown 关断传输延时	_	130	200	ns	
t R	开启上升时间	_	75	130	ns	`(
t⊧	关闭下降时间	_	35	70	ns	
DT	死区时间	400	520	650	ns	
MT	延迟匹配时间(ton, toff)	_	_	50	ns	
MDT	死区匹配时间	_	- (60	ns	

5.6.2 静态参数特性

无特殊说明的情况下 $V_{CC}=V_{BS}=15V$, $T_A=25^{\circ}C$ 。 V_{IH} 、 V_{IL} 和 I_{IN} 参数参考 V_{SS} ,相应的适用于输入引脚 HIN 和 LIN。 V_O 和 I_O 参数参考 V_{SS} ,并且相应的适用于输出引脚 HO 和 LO。

符号	定义	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
V _{CCUV+}	Vcc 欠压正向阈值	8	8.9	9.8	V	
V _{CCUV} -	Vcc 欠压负向阈值	7.4	8.2	9.0	V	
Vccuvhy s	Vcc迟滞电压	_	0.7	_	V	
ILK	高侧浮动电源泄露电流(700V)	_	_	50	μA	V _B =V _S =700V
IQBS	V _{BS} 静态电流	_	50	100	μA	V _{IN} =0V or 5V
lacc	Vcc静态电流	_	120	240	μA	V _{IN} =0V or 5V
VIH	输入逻辑高电平阈值电压	2.5	_	_	V	VCC=10Vto 20V
VIL	输入逻辑低电平阈值电压	_	_	0.8	V	VCC=10Vto 20V
Vон	输出高电平电压降 V _{BIAS} - vo	_	_	0.1	V	I _O =0A
Vol	输出低电平电压降 Vo	_	_	0.1	V	I _O =0A
I _{IN+}	逻辑"1" 输入偏置电流	_	5	10	μA	IN=5V
I _{IN} -	逻辑 "0" 输入偏置电流	_	_	2	μA	IN=0V
I _{SD+}	SD输入偏置电流	_	5	10	μA	SD=5V
I _{SD} -	SD输入偏置电流		0	2	μA	SD=0V
I _{O+}	输出拉电流	200	300		mA	V _O =0V PW≤10us
l ₀ -	输出灌电流	400	600	_	mA	V₀=15V PW≤10us



6 功能描述

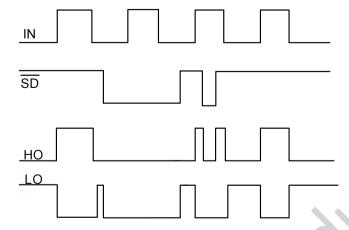


Figure 5. IRS2104S Input and output timing waveform

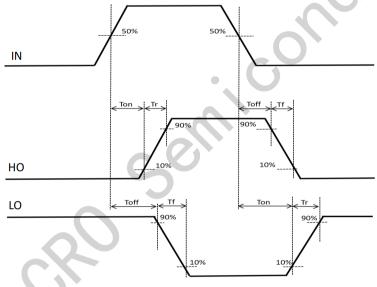


Figure 6. Propagation Time Waveform Definition

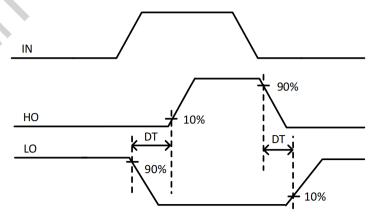


Figure 7. Cross Conduction Prevention Delay Time Waveform Definition



7 IRS2104STRPBF说明

7.1 功能框图

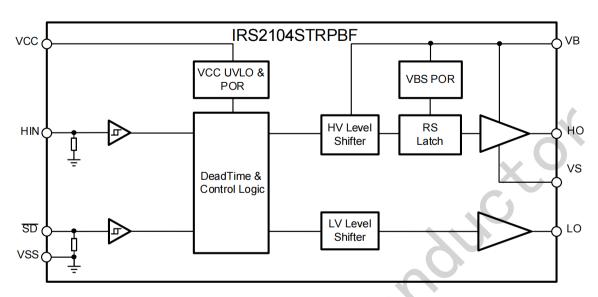


图 7-1 IRS2104S的功能框图

7.2 典型应用电路

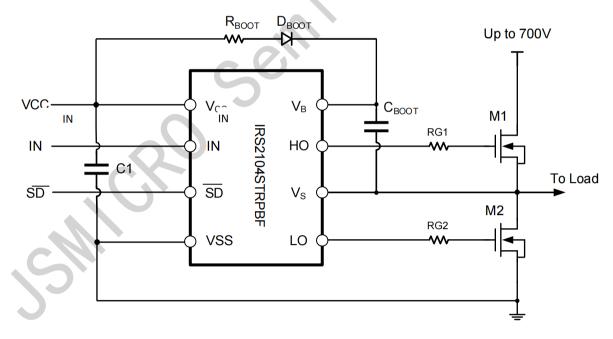
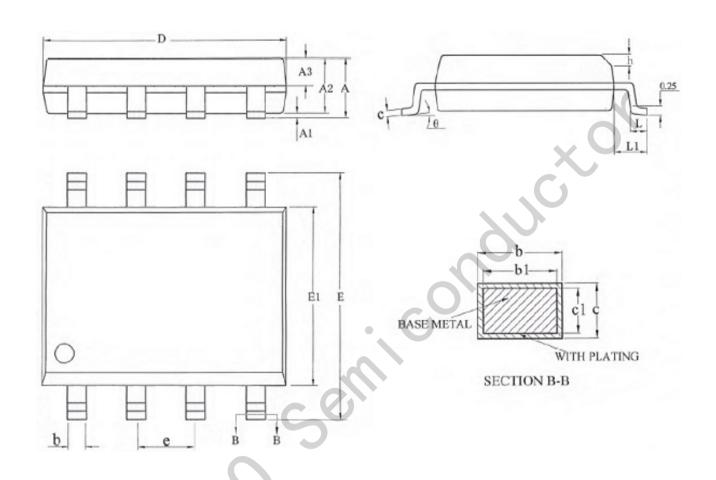


图 7-2 IRS2104S典型应用电路图



8.封装信息

SOIC-8 Package Outlines



SOIC-8 Package Dimensions

Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)	Size Symbol	MIN(mm)	TYP(mm)	MAX(mm)
Α	-	-	1.75	D	4.70	4.90	5.10
A1	0.10	ı	0.225	Е	5.80	6.00	6.20
A2	1.30	1.40	1.50	E1	3.70	3.90	4.10
A3	0.60	0.65	0.70	е		1.27BSC	
b	0.39	•	0.48	h	0.25	_	0.50
b1	0.38	0.41	0.43	L		0.50	
С	0.21	-	0.26	L1	1.05BSC		
c1	0.19	0.20	0.21	θ	0	_	8°

单击下面可查看定价,库存,交付和生命周期等信息

>>JSMSEMI (杰盛微)